

	<p>SIS435DNT-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIS435DNT-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 30A 1212-8</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  SIS435DNT-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


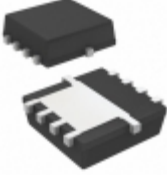

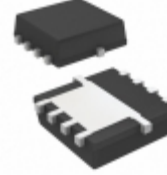




Spezifikationen

Teilenummer	SIS435DNT-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 30A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 13A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SIS435DNT-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5700pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	180nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 30A (Tc) 3.7W (Ta), 39W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SIS435DNT-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIS435DNT-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIS435DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIS435DNT-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIS436DN Vishay SIS436DN Vishay</p>	 <p>SIS434DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS434DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS436DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 16A PPAK 1212-8</p>
 <p>SIS430DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 25V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS430DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 25V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS438DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 16A PPAK 1212-8</p>	 <p>SIS434DN-T1-E3 VISHAY VISHAY QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIS435DNT-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIS435DNT-T1-GE3 Datenblatt	SIS435DNT-T1-GE3-Datenblätter	SIS435DNT-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIS435DNT-T1-GE3
SIS435DNT-T1-GE3 Electronic	SIS435DNT-T1-GE3-Komponenten	SIS435DNT-T1-GE3-Verteiler	SIS435DNT-T1-GE3-Bild	SIS435DNT-T1-GE3-Teil
SIS435DNT-T1-GE3 Preis	SIS435DNT-T1-GE3 Hersteller	SIS435DNT-T1-GE3 Bild	SIS435DNT-T1-GE3 Aktie	SIS435DNT-T1-GE3 Inventar
SIS435DNT-T1-GE3 Neu	SIS435DNT-T1-GE3 Original	SIS435DNT-T1-GE3 garantiert	SIS435DNT-T1-GE3 RFQ	SIS435DNT-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited